(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-6501

(P2002-6501A)

(43)公開日 平成14年1月9日(2002.1.9)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコート*(参考)
G03F 7/039	601	G03F 7/039	601 2H025
C08F 220/18		C 0 8 F 220/18	4J002
220/22	·	220/22	4 J 1 0 0
222/04		222/04	
232/00		232/00	
	審查請求	未請求 請求項の数9 OL	(全 18 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2000-332641(P2000-332641)	(71)出願人 000002093	
		住友化学工業	終 式会社
(22)出顧日	平成12年10月31日(2000.10.31)	大阪府大阪市	中央区北浜4丁目5番33号
		(72)発明者 上谷 保則	
(31)優先権主張番号	特顧平11-318116	大阪市此花区	【春日出中3丁目1番98号 住
(32)優先日	平成11年11月9日(1999.11.9)	友化学工業校	试会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 橋本 和彦	·
(31)優先権主張番号	特顧2000-29159 (P2000-29159)	大阪市此花区	X春日出中3丁目1番98号 住
(32) 優先日	平成12年2月7日(2000.2.7)	友化学工業校	社会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人 100093285	
		1	

(54) 【発明の名称】 化学増幅型レジスト組成物

(31)優先権主張番号 特顧2000-29156(P2000-29156)

日本 (JP)

平成12年2月7日(2000.2.7)

(57)【要約】

(32)優先日

(33)優先権主張国

【課題】170 mi以下の波長の光に対する透過率に優 れ、特に下、エキシマレーザーリソグラフィに適したレ ジスト組成物を提供する。

【解決手段】バインダー樹脂及び感放射線化合物を含有 し、該パインダー樹脂が、それ自身アルカリ可溶性であ るか又は放射線照射後の該感放射線化合物の作用により 化学変化を起こしてアルカリ可溶性となるものであっ て、下式(1)

$$CH_2 = C - C - O - R^1$$
 (I)

(式中、Qは水素、メチル又は炭素数1~4のフルオロ アルキルを表し、R¹はハロゲン、水酸基もしくは脂環 式環で置換されていても良い炭素数1~14のアルキ ル、又はハロゲン、水酸基、アルキル基で置換されてい ても良い脂環式環もしくはラクトン環を表し、Q、R1 のうちの少なくとも一方は、少なくとも1個のフッ素原 子を有する。) で示されるモノマーから導かれる重合単 位を有する化学増幅型レジスト組成物。

弁理士 久保山 隆 (外2名)

最終頁に続く

【特許請求の範囲】

【請求項1】パインダー樹脂及び感放射線化合物を含有し、該パインダー樹脂が、それ自身アルカリ可溶性であるか又は放射線照射後の該感放射線化合物の作用により化学変化を起としてアルカリ可溶性となるものであって、下式(1)

$$CH_2 = C - C - O - R^1$$
 (I)

(式中、Qは水素、メチル又は炭素数 1~4のフルオロアルキルを表し、R¹はハロゲン、水酸基もしくは脂環式環で置換されていても良い炭素数 1~14のアルキル、又はハロゲン、水酸基、アルキル基で置換されていても良い脂環式環もしくはラクトン環を表し、Q、R¹のうちの少なくとも一方は、少なくとも1個のフッ素原子を有する。)で示されるモノマーから導かれる重合単位を有することを特徴とする化学増幅型レジスト組成物。

【請求項2】式(I)におけるQが、トリフルオロメチ 20 ルである請求項1に記載の組成物。

【請求項3】式(I)における R^1 が、少なくとも1個のフッ素で置換された水酸基を有することもある炭素数 $1\sim14$ のフルオロアルキルである請求項1又は2記載の組成物。

【請求項4】少なくとも1個のフッ素で置換された水酸基を有することもある炭素数1~14のフルオロアルキルが下式(II)

$$-\left(\begin{array}{c} OH \\ CH_2CH \end{array}\right) \begin{array}{c} R^2 \\ CH-R^3 \end{array} (II)$$

(式中、 R^{2} は水素、アルキル又はフルオロアルキルを表し、 R^{3} はフルオロアルキルを表し、 R^{2} と R^{3} の合計炭素数は $1\sim11$ である。nは0または1を表す。)で示される基である請求項3記載の組成物。

【請求項5】感放射線化合物が放射線の作用により酸又は塩基を発生する活性化合物であって、ボジ型に作用する請求項1~4いずれかに記載の組成物。

【請求項6】バインダー樹脂が酸又は塩基の作用で解裂する基を有し、それ自身はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸又は塩基の作用でアルカリ可溶性となる請求項5記載の組成物。

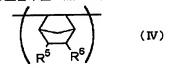
【請求項7】バインダー樹脂が、式(I)のモノマーから導かれる重合単位に加えて、下式(III)

$$CH_2 = \stackrel{R}{C} - \stackrel{R}{C} - O \qquad (III)$$

(式中 、Rは水素又はメチルを表し、R' はアルキル

を表す)で示される(メタ)アクリル酸2-アルキルー2-アダマンチルから導かれる重合単位を有し、感放射線化合物が、放射線の作用により酸を発生する酸発生剤である請求項5又は6記載の組成物。

【請求項8】バインダー樹脂が、式(I)のモノマーから導かれる重合単位に加えて、下式(IV)



(式中、R'及びR'は互いに独立に、水素、炭素数1~3のアルキル、炭素数1~3のヒドロキシアルキル、カルボキシル、シアノ若しくは基-COOR'(R'はアルコール残基である)を表すか、又はR'とR'が一緒になって、-C(=0)OC(=0)-で示されるカルボン酸無水物残基を形成する。)並びに無水マレイン酸及び無水イタコン酸から選ばれる不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位で示される脂環式オレフィンの重合単位を含有する請求項5~7いずれかに記載の組成物。

【請求項9】バインダー樹脂がそれ自身アルカリ可溶性 であり、さらに架橋剤を含有し、ネガ型に作用する請求 項1~4いずれかに記載の組成物。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の微細加工 に用いられる化学増幅型レジスト組成物に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】半導体の微細加工には通常、レジスト組 成物を用いたリソグラフィブロセスが採用されており、 リソグラフィにおいては、レイリー (Rayleigh) の回折 限界の式で表される如く、原理的には露光波長が短いほ ど解像度を上げることが可能である。半導体の製造に用 いられるリソグラフィ用露光光源は、波長436mmのg 線、波長365nmのi線、波長248nmのKrFエキシ マレーザー、波長193nmのArFエキシマレーザーと 年々短波長になってきており、さらに次世代の露光光源 として波長157nmのF、エキシマレーザーが有望視さ れている。KrFエキシマレーザー露光やArFエキシ マレーザー露光用には、露光により発生する酸の触媒作 用を利用したいわゆる化学増幅型レジストが、感度に優 れることから多く用いられている。そしてF、エキシマ レーザー露光用にも、感度の点で化学増幅型レジストが 使われる可能性が高い。

【0003】KrFエキシマレーザー露光用のレジスト には、ポリピニルフェノール系の樹脂が用いられてき た。一方、ArFエキシマレーザー露光用のレジストに 用いる樹脂は、レジストの透過率を確保するために芳香 50 環を持たず、またドライエッチング耐性を持たせるため

に、芳香環の代わりに脂環式環を有するものがよいことが知られている。このような脂環式の樹脂としては、D. C. Hofer, Journal ofPhotopolymer Science and Te chnology, Vol.9, No.3, 387–398 (1996) に記載されるような各種のものが知られている。また、S. Takechi e t al, Journal ofPhotopolymer Science and Technolog y, Vol.9, No.3, 475–487 (1996) や特開平 9-73173号公報には、メタクリル酸2ーメチルー2ーアダマンチルの重合体又は共重合体を化学増幅型レジストの樹脂として用いた場合には、2ーメチルー2ーアダマンチルが酸の作用により解裂してポジ型に作用するとともに、高いドライエッチング耐性、高解像性及び基板への良好な接着性が得られることが報告されている。

【0004】しかしながら、従来のKrFエキシマレーザー露光やArFエキシマレーザー露光用のレジストに用いられている樹脂は、170nm以下の波長の光、例えば、波長157nmのF。エキシマレーザーに対して、充分な透過率を示さなかった。透過率が低いと、プロファイル、コントラスト、感度などの諸性能に悪影響を及ぼす。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明の目的は、170m以下の波長の光に対する透過率に優れ、特に下、エキシマレーザーリソグラフィに適したレジスト組成物を提供することにある。本発明者らは、レジスト組成物を構成する樹脂として、特定のモノマーに由来する重合単位を有する樹脂を用いることにより、157mの下、エキシマレーザーの波長における透過率の改良ができることを見出し、本発明を完成した。

[0006]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、バインダー樹脂及び感放射線化合物を含有し、バインダー樹脂が、それ自身アルカリ可溶性であるか又は放射線照射後の感放射線化合物の作用により化学変化を起こしてアルカリ可溶性となるものであって、下式(I)

$$CH_2 = \overset{Q}{C} - \overset{Q}{C} - O - R^1$$
 (I)

【0008】(式中、Qは水素、メチル又は炭素数1~4のフルオロアルキルを表し、R¹はハロゲン、水酸基もしくは脂環式環で置換されていても良い炭素数1~14のアルキル、又はハロゲン、水酸基、アルキル基で置換されていても良い脂環式環もしくはラクトン環を表し、Q、R¹のうちの少なくとも一方は、少なくとも1個のフッ素原子を有する。)で示されるモノマーから導かれる重合単位を有する化学増幅型のレジスト組成物を提供するものである。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明では、上記式(I)に示すとおり、Q、R¹のうちの少なくとも一方が、少なくとも1個のフッ素原子を有する(メタ)アクリル酸エステル類に由来する重合単位を有する樹脂を用いる。ここでQは、水素、メチル又は炭素数1~4のフルオロアルキルを表すが、このフルオロアルキルは、炭素数3以上の場合は直鎖でも分岐していてもよい。またこのフルオロアルキルは、少なくとも1個のフッ素原子を有していればよいが、フッ素原子を2個以上有しているのが好ましい。トリフルオロメチル基のものが入手が容易なことかち、現実的である。

【0010】またR1は、ハロゲン、水酸基もしくは脂 環式環で置換されていても良い炭素数1~14のアルキ ル、又はハロゲン、水酸基、アルキル基で置換されてい ても良い脂環式環もしくはラクトン環を表す。ハロゲ ン、水酸基もしくは脂環式環で置換されていても良い炭 素数1~14のアルキルは、炭素数3以上の場合は直鎖 でも分岐していてもよい。ととでハロゲンとしては、例 えばフッ素、塩素、臭素等が挙げられる。脂環式環とし 20 ては、例えばシクロペンチル環、シクロヘキシル環、ビ シクロ[2.2.1] ヘプチル環、ビシクロ[4.3. 0] ノニル環、ビシクロ[4.4.0] デカニル環、ト リシクロ[5.2.1.02.6] デカニル環、アダマン チル環等が挙げられる。なかでも少なくとも1個のフッ 素で置換された水酸基を有することもある炭素数1~1 4のフルオロアルキルが好ましい。ハロゲン、水酸基、 アルキル基で置換されていても良い脂環式環もしくはラ クトン環におけるアルキル基は、炭素数が1~4程度の 低級アルキル基であるのが通常である。炭素数3以上の 30 場合は直鎖でも分岐していてもよい。ハロゲンとして は、例えば上記と同様なものが、脂環式環としては、例 えば上記と同様な脂環式環が挙げられる。またラクトン 環としては、例えば2-オキソオキセタン-3-イル 環、2-オキソオキソラン-3-イル環、2-オキソオ キサン-3-イル環、2-オキセパノン-3-イル環等 が挙げられる。

【0011】R¹が少なくとも1個のフッ素原子を有している場合は、市場からモノマー(I)の入手のし易さを考慮すると、R¹は下式(II)

40 [0012]

$$-\left(CH_{2}CH\right)_{n}^{R^{2}}CH-R^{3} \quad (II)$$

(式中、R² は水素、アルキル又はフルオロアルキルを表し、R³ はフルオロアルキルを表し、R² とR³ の合計炭素数は1~11である。nは0または1を表す。) であることが好ましい。ここにおけるアルキル、フルオロアルキルは、炭素数が3以上である場合は、直鎖でも分岐していてもよい。またフルオロアルキルは、少なく50 とも1個のフッ素原子を有しておれば良いが、フッ素原

子を2個以上有しているものが好ましい。もちろんパーフルオロアルキルであっても良い。また水酸基が置換されている場合は、親水性が増大する結果、現像液へのなじみを向上し得る。

【0013】式(I)で示される(メタ)アクリル酸フルオロアルキルの具体例としては、次のような化合物を挙げることができる。

【0014】アクリル酸2,2,2-トリフルオロエチル、メタクリル酸2,2,2-トリフルオロエチル、アクリル酸1-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロメチル-2,2,2-トリフルオロエチル、メタクリル酸2,

2, 3, 3-テトラフルオロプロビル、メタクリル酸 2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブチル、アクリル酸1H, 1H, 11H-エイコサフルオロウンデシル、メタクリル酸1H, 1H, 11H-エイコサフルオロウンデシル、

【0015】メタクリル酸 3-(パーフルオロ-3-メ*

など。

【0017】とのような式(1)で示されるモノマーの 重合によって、下式(Ia)で示される単位が形成される ととになる。

[0018]

* チルブチル)-2-ヒドロキシプロピル、メタクリル酸 3 – (バーフルオロー5 – メチルヘキシル) – 2 – ヒドロ キシブロビル、メタクリル酸 3-(パーフルオロ-7-メチルオクチル)-2-ヒドロキシプロピル、メタクリ ル酸 3-(パーフルオロブチル)-2-ヒドロキシブロ ビル、メタクリル酸 3-(パーフルオロヘキシル)-2 -ヒドロキシプロピル、メタクリル酸 3-(パーフルオ ロオクチル)-2-ヒドロキシプロピル、メタクリル酸 3-(パーフルオロ-3-メチルブチル)-2-ヒドロキ シブロビル、アクリル酸 3-(パーフルオロ-5-メチ ルヘキシル)-2-ヒドロキシプロピル、アクリル酸 3 -(パーフルオロ-7-メチルオクチル)-2-ヒドロキ シプロビル、アクリル酸 3-(パーフルオロプチル)-2-ヒドロキシブロビル、アクリル酸 3-(パーフルオ ロヘキシル)-2-ヒドロキシプロピル、アクリル酸 3 -(パーフルオロオクチル)-2-ヒドロキシプロピル、 [0016]

【0019】式中、Q及びR¹ は先に定義したとおりで ある。

[0020]また、本発明に用いるバインダー樹脂は、 50 それ自身アルカリ可溶性であるか又は放射線照射後に後

述する感放射線化合物の作用により化学変化を起こして アルカリ可溶性となるものである。このような、それ自 身アルカリ可溶性であるか又は放射線照射後に感放射線 化合物の作用により化学変化を起こしてアルカリ可溶性 となる性質は、アルカリ現像タイプの化学増幅型レジストに一般的に求められるものであり、したがって、化学 増幅型レジストにおいて従来から知られている技術を応 用して、このような性質を付与することができる。

【0021】バインダー樹脂がそれ自身アルカリ可溶性 であるか、又は放射線照射後の感放射線化合物の作用に よりアルカリ可溶性となるものであり、当該バインダー 樹脂を含むレジスト膜の放射線照射部がアルカリ現像に よって除去される場合は、ポジ型レジストとなる。すな わち、化学増幅型のポジ型レジストは、放射線照射部で 感放射線化合物から発生した酸又は塩基が、その後の熱 処理 (post exposurebake) によって拡散し、樹脂等の 保護基を解裂させるとともに酸又は塩基を再生成するこ とにより、その放射線照射部をアルカリ可溶化する。化 学増幅型ポジ型レジストには、バインダー樹脂がアルカ リ可溶性であり、とのバインダー樹脂及び感放射線化合 物に加えて、酸又は塩基の作用により解裂しうる保護基 を有し、それ自身はアルカリ可溶性バインダー樹脂に対 して溶解抑止能を持つが、酸又は塩基の作用により上記 保護基が解裂した後はアルカリ可溶性となる溶解抑止剤 を含有するものと、バインダー樹脂が酸又は塩基の作用 により解裂しうる保護基を有し、それ自身はアルカリに 不溶又は難溶であるが、酸又は塩基の作用により上記保 護基が解裂した後はアルカリ可溶性になるものとがあ る。

【0022】一方、バインダー樹脂がアルカリ可溶性であり、当該バインダー樹脂を含むレジスト膜の放射線照射部が硬化し、アルカリ現像によって放射線の照射されていない部分が除去される場合は、ネガ型レジストとなる。すなわち、化学増幅型のネガ型レジストは通常、バインダー樹脂がアルカリ可溶性であり、このバインダー樹脂及び感放射線成分に加えて架橋剤を含有し、放射線照射部で感放射線化合物から発生した酸又は塩基がその後の熱処理(post exposure bake)によって拡散し、架橋剤に作用してその放射線照射部のバインダー樹脂を硬化させ、アルカリ不溶化させる。

【0023】本発明で用いるバインダー樹脂におけるアルカリ可溶性部位は、例えば、フェノール骨格を有する単位や、(メタ)アクリル酸エステル骨格を有し、エステルのアルコール側に脂環式環及びカルボキシル基を有する単位、不飽和カルボン酸の単位などでありうる。具体的には、ビニルフェノール単位、イソブロペニルフェノール単位、(メタ)アクリル酸の脂環式エステルであって、その脂環式環にカルボキシル基を有する単位、(メタ)アクリル酸単位などが挙げられる。このような

(メタ)アクリル酸単位などが挙げられる。このような アルカリ可溶性の単位を比較的多く存在させることによ 50

り、その樹脂自体がアルカリ可溶性となる。もちろん、これらの単位とともに、アルカリ不溶性の単位が存在していてもよく、例えば、ビニルフェノール単位又はイソプロペニルフェノール単位の水酸基の一部がアルキルエーテル化された混合単位を有する樹脂、ビニルフェノールと他の重合性不飽和化合物との共重合によって得られる混合単位を有する樹脂、(メタ)アクリル酸の脂環式エステルと(メタ)アクリル酸との共重合によって得られる混合単位を有する樹脂なども、全体としてアルカリ可溶であれば、本発明で規定するそれ自身アルカリ可溶性である樹脂となりうる。

【0024】一方、それ自身はアルカリに不溶又は難溶 であるが、放射線照射後の感放射線化合物の作用により アルカリ可溶性になる樹脂をパインダーとする場合、と のような性質を有する部位は、例えば、先に例示したフ ェノール骨格を有する単位やカルボキシル基を有する単 位のようなアルカリ可溶性単位に、アルカリ現像液に対 して溶解抑止能を持つが、酸又は塩基の作用により解裂 しうる保護基を導入したものでありうる。アルカリ現像 液に対しては溶解抑止能を持つが、酸又は塩基に対して 不安定な基は、公知の各種保護基であることができる。 【0025】アルカリ現像液に対しては溶解抑止能を持 つが、酸に対して不安定な基としては、例えば、tert-ブチル、tert-ブトキシカルボニル及びtert-ブトキシ カルボニルメチルのような4級炭素が酸素原子に結合す る基;テトラヒドロ-2-ピラニル、テトラヒドロ-2 -フリル、1-エトキシエチル、1-(2-メチルプロ ポキシ) エチル、1-(2-メトキシエトキシ) エチ ル、1-(2-アセトキシエトキシ)エチル、1-[2 - (1-アダマンチルオキシ)エトキシ〕エチル及び1 - [2-(1-アダマンタンカルボニルオキシ)エトキ シ] エチルのようなアセタール型の基;3-オキソシク ロヘキシル、4-メチルテトラヒドロ-2-ピロン-4 - イル (メパロニックラクトンから導かれる) 及び2 -アルキル-2-アダマンチルのような非芳香族環状化合 物の残基などが挙げられ、これらの基が、フェノール性 水酸基の水素又はカルボキシル基の水素に置換すること になる。これらの保護基は、フェノール性水酸基又はカ ルボキシル基を有するアルカリ可溶性樹脂に、公知の保 護基導入反応を施すことによって、又はこのような基を 有する不飽和化合物を一つのモノマーとする共重合を行 うことによって、樹脂中に導入することができる。 【0026】一方、塩基に対して不安定な基の例として

【0026】一方、塩基に対して不安定な基の例としては、アルキルカーバメート又はシクロアルキルカーバメート系の基が挙げられる。具体的には例えば、フェノール骨格を有し、そのフェノール性水酸基の一部がアルキルカルバモイルオキシ基やシクロアルキルカルバモイルオキシ基で置き換えられた単位を有する樹脂が、このようなタイプのバインダー樹脂となりうる。

【0027】本発明では、バインダー樹脂中に、前記式 (1)で示されるモノマー中にアルカリ可溶性基を有す る重合単位又は放射線照射後に感放射線化合物の作用に より化学変化を起としてアルカリ可溶性となる基を有す る場合以外は、前記式(I)で示されるモノマーから導 かれる重合単位に加えて、以上説明したようなアルカリ 可溶性基を有する重合単位又は放射線照射後に感放射線 化合物の作用により化学変化を起こしてアルカリ可溶性 となる基を有する重合単位を存在させることになる。そ の場合、この樹脂は、式(I)で示されるモノマーを一 10 つのモノマーとし、アルカリ可溶性基を有するか、又は 放射線照射後に感放射線化合物の作用により化学変化を 起こしてアルカリ可溶性となる基を有する重合性不飽和 化合物を別のモノマーとして、共重合を行うことによ り、製造される。共重合自体は常法に従って行うことが でき、例えば、適当な溶媒中に各モノマーを溶解し、重 合開始剤の存在下に重合を開始し、反応を進めればよ い。また、例えばビニルフェノールやイソプロペニルフ ェノールの単位における水酸基を、アルキルや放射線照 射後に感放射線化合物の作用により脱離する基で修飾す 20 る場合は、式(1)で示されるモノマーとビニルフェノ ール又はイソプロペニルフェノールとを共重合させた 後、ビニルフェノール単位又はイソプロペニルフェノー ル単位の水酸基を修飾するのが一般的である。

【0028】式(1)のモノマーから導かれる重合単位 をバインダー樹脂中に組み込むことにより、この樹脂 は、170 nm以下の波長の光、例えば波長157 nmのF 、エキシマレーザーに対する透過率に優れたものとな る。したがって、式(I)のモノマーから導かれる重合 単位は、このような性能が達成でき、かつ樹脂自身がア ルカリ可溶性であるか、又は放射線照射後に感放射線化 合物の作用によりアルカリ可溶性となる範囲で存在させ ればよい。レジストの種類やタイプにもよるが、一般的 には、式(I)のモノマーから導かれる重合単位の割合 は、樹脂全体のうち、10~100モル%程度の範囲か ら適宜選択すればよい。

【0029】アルカリ可溶性の単位を比較的多く存在さ せることにより、その樹脂自身がアルカリ可溶性とな る。それ自身がアルカリ可溶性であるバインダー樹脂 は、溶解抑止剤及び感放射線化合物と組み合わせて、ポ 40 ジ型レジストとするととができ、また架橋剤及び感放射 線化合物と組み合わせて、ネガ型レジストとすることが

【0030】アルカリ可溶性樹脂自体をバインダーと し、ポジ型レジストとする場合に用いられる溶解抑止剤 は、フェノール系化合物のフェノール性水酸基を、アル カリ現像液に対しては溶解抑止能を持つが、酸又は塩基 の作用により解裂する基で保護した化合物でありうる。 酸の作用により解裂する基としては、例えば、tert-ブ トキシカルボニル基が挙げられ、これがフェノール性水 50 もありうる。放射線照射後に感放射線化合物の作用によ

酸基の水素に置換することになる。酸の作用により解裂 する基を有する溶解抑止剤には、例えば、2,2-ビス (4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル)プロ パン、ピス(4 - tert-ブトキシカルボニルオキシフェ ニル)スルホン、3、5-ビス(4-tert-ブトキシカ ルボニルオキシフェニル)-1,1,3-トリメチルイ ンダンなどが包含される。一方、塩基の作用により解裂 する基としては、例えば、アルキルカーパメート又はシ クロアルキルカーパメート系の基が挙げられ、フェノー ル性水酸基をアルキルカルバモイルオキシ基やシクロア ルキルカルバモイルオキシ基で置き換えた化合物が、塩 基の作用により解裂する基を有する溶解抑止剤となりう る。このような溶解抑止剤を用いる場合は、バインダー 樹脂とともにバインダー成分に含めて考慮するのが好都 合である。

【0031】アルカリ可溶性樹脂自体をバインダーと し、ネガ型レジストとする場合に用いられる架橋剤は、 酸又は塩基の作用によりバインダー樹脂を架橋させるも のであればよい。架橋剤は一般に、酸の作用により架橋 反応を起こすものであることが多く、通常は、メチロー ル基を有する化合物又はそのアルキルエーテル体が用い られる。具体例としては、ヘキサメチロールメラミン、 ベンタメチロールメラミン、テトラメチロールメラミ ン、ヘキサメトキシメチルメラミン、ペンタメトキシメ チルメラミン及びテトラメトキシメチルメラミンのよう なメチロール化メラミン又はそのアルキルエーテル体、 テトラメチロールベンゾグアナミン、テトラメトキシメ チルベンゾグアナミン及びトリメトキシメチルベンゾグ アナミンのようなメチロール化ベンゾグアナミン又はそ のアルキルエーテル体、2,6-ビス(ヒドロキシメチ ル) - 4 - メチルフェノール又はそのアルキルエーテル 体、4-tertープチルー2,6-ビス(ヒドロキシメチ ル) フェノール又はそのアルキルエーテル体、 5-1 チルー1、3-ビス(ヒドロキシメチル)ペルヒドロー 1.3,5-トリアジン-2-オン(通称N-エチルジ メチロールトリアゾン)又はそのアルキルエーテル体、 N. N-ジメチロール尿素又はそのジアルキルエーテル 体、3,5-ピス(ヒドロキシメチル)ペルヒドロー 1, 3, 5-オキサジアジン-4-オン(通称ジメチロ ールウロン) 又はそのアルキルエーテル体、テトラメチ ロールグリオキザールジウレイン又はそのテトラメチル エーテル体などが挙げられる。

【0032】一方、放射線照射後の感放射線化合物の作 用により化学変化を起としてアルカリ可溶性になる単位 と、式([)のモノマーから導かれる単位とを有するバ インダー樹脂は、感放射線化合物と組み合わせて、ポジ 型レジストとすることができる。式(1)のモノマー中 自体が、放射線照射後の感放射線化合物の作用により化 学変化を起としてアルカリ可溶性になる単位になる場合

り化学変化を起としてアルカリ可溶性になる単位のなかでも、(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチル類から導かれる重合単位を有するものは、解像度やドライエッチング耐性の点で優れている。(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチル類は、具体的には下式(III)で表すことができ、それの重合によって、下式(IIIa)の単位が形成されることになる。

[0033]

$$CH_{2} = \stackrel{R}{C} - \stackrel{R}{$$

【0034】式中、Rは水素、メチル又は炭素数1~4のフルオロアルキルを表し、R'はアルキルを表す。R'で表されるアルキルは、例えば炭素数1~8程度であることができ、通常は直鎖であるのが有利であるが、炭素数3以上の場合は分岐していてもよい。具体的なR'としては、メチル、エチル、プロビル、イソプロビル、ブチルなどが挙げられる。式(IIIa)で示される(メタ)アクリル酸2-アルキルー2-アダマンチル類の重合単位では、2-アルキルー2-アダマンチルが酸の作用により解裂するので、この単位を有する樹脂は、感放射線化30合物として酸発生剤を用いたボジ型レジストに適用することができる。

【0035】パインダー樹脂が、式(I)の導かれる重合単位に加えて、下式(IV)

(式中、 R'及びR'は互いに独立に、水素、炭素数 1 ~3のアルキル、炭素数 1~3のヒドロキシアルキル、カルボキシル、シアノ若しくは基-COOR'(R'はアルコール残基である)を表すか、又はR'とR'が一緒になって、-C(=0)OC(=0)-で示されるカルボン酸無水物残基を形成する。)並びに無水マレイン酸及び無水イタコン酸から選ばれる不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位で示される脂環式オレフィンの重合単位を含有することは、ドライエッチング耐性を上げる上で特に有効である。

【0036】式 (IV) 中のR'及びR'は互いに独立に、

水素、炭素数1~3のアルキル、炭素数1~3のヒドロ キシアルキル、カルボキシル、シアノ若しくは基-CO OR'(R'はアルコール残基である)を表すか、又はR *とR*が一緒になって、-C(=0)OC(=0)- で示されるカル ボン酸無水物残基を形成することもできる。R⁵及び/ 又はR⁶がアルキルである場合の具体例としては、メチ ル、エチル、プロピルなどが挙げられ、同じくヒドロキ シアルキルである場合の具体例としては、ヒドロキシメ チル、2-ヒドロキシエチルなどが挙げられる。R5及 10 び/又はR'が基-COOR'である場合は、カルボキシ ルがエステルとなったものであり、R'に相当するアル コール残基としては、例えば、置換されていてもよい炭 素数1~8程度のアルキル、2-オキソオキソラン-3 -又は-4-イルなどを挙げることができ、ここにアル キルの置換基としては、水酸基や脂環式炭化水素残基な どが挙げられる。そこで、R'及び/又はR'が-COO R⁷で示されるカルボン酸エステル残基である場合の具 体例としては、メトキシカルボニル、エトキシカルボニ ル、2-ヒドロキシエトキシカルボニル、tert-ブトキ 20 シカルボニル、2-オキソオキソラン-3-イルオキシ カルボニル、2-オキソオキソラン-4-イルオキシカ ルボニル、1、1、2-トリメチルプロポキシカルボニ ル、1-シクロヘキシル-1-メチルエトキシカルボニ ル、1-(4-メチルシクロヘキシル)-1-メチルエ トキシカルボニル、1-(1-アダマンチル)-1-メ チルエトキシカルボニルなどが挙げられる。

[0037] また式(IV) で示される脂環式オレフィンの重合単位に導くためのモノマーとして、具体的には例えば、次のような化合物を挙げることができる。

【0038】2-ノルボルネン

2-ヒドロキシ-5-ノルボルネン

5-ノルボルネン-2-カルボン酸

5-ノルボルネン-2-カルボン酸メチル

5-ノルボルネン-2-カルボン酸-t-ブチル

5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-シクロヘキシル -1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(4-メチルシクロヘキシル)-1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(4-ヒドロキシシクロヘキシル)-1-メチルエチル、5-ノルボン酸1-メチル-1-(4-オキソシクロヘキシル)エチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(1-アダマンチル)-1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-メチルシクロヘキシル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-エチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-エチル-2-アダマンチル5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-ヒドロキシ-1-エチル、5-ノルボルネン-2-メタノール、5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸無水物など。

【0039】不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位は、

14

無水マレイン酸の重合単位及び無水イタコン酸の重合単位から選ばれ、それぞれ下式(V)及び下式(VI)で示すことができる。これらのの重合単位に導くためのモノマーとして、具体的には無水マレイン酸、無水イタコン酸などが挙げられる。

13

[0040]

$$\begin{pmatrix}
CH_2 & C \\
CV
\end{pmatrix}$$
(VI)

* [0041]式(I)のモノマーから導かれる重合単位が組み込まれ、それ自身がアルカリ可溶性であるか、又は放射線照射後の感放射線化合物の作用により化学変化を起こしてアルカリ可溶性となるバインダー樹脂について、典型的ないくつかの例を挙げると、以下の式(VII)~(XXVIII)で示される各単位を有するものなどがある。

[0042]

*

CH2 CH3

CH2 CF3

CH2 CF3

CH2 CF3

CH2 CF3

CH2 CF3

CH2 CF3

CH3 CF3

CH2 CF3

CH3 CF3

CH4 CF3

CH3 CF3

CH3 CF3

CH4 CF3

CH3 CF3

CH4 CF4

CH4 CF3

CH4 CH4

CH4 CF3

CH4 CF4

CH4 CF3

CH4 CF4

CH4 CF4

CH4 CF4

CH4 CF5

CH4 CF4

CH4 CF4

CH4 CF5

CH4 CF5

CH4 CF5

CH5 CF4

CH4 CF5

CH5 CF4

CH4 CF5

CH5 CF5

[0043]

【0044】式中、R®は水酸基の保護基を表す。ここ でいう水酸基の保護基は、先に説明したアルキルや、酸 又はアルカリの作用により解裂する基として例示した各 種の基でありうる。

【0045】以上のような、アルカリ可溶性の又はアル カリ可溶性となりうる樹脂をバインダーとする化学増幅 型レジストは、放射線の作用により分解する感放射線化 合物を含有する。バインダー樹脂がアルカリ可溶性であ って、溶解抑止剤として酸の作用により解裂する基を有 する化合物を用い、ポジ型に作用させる場合や、バイン ダー樹脂が酸の作用により解裂する基を有し、それ自身 はアルカリに不溶又は難溶であるが、酸の作用により解 裂する基が解裂した後はアルカリ可溶性となるものであ って、ポジ型に作用させる場合は、感放射線化合物とし て、放射線の作用により酸を発生する酸発生剤が用いら れる。また、バインダー樹脂がアルカリ可溶性であっ て、架橋剤を含有するネガ型レジストの場合は、架橋剤 が酸の作用により架橋反応を起こすものであることが多 いことから、感放射線化合物としては、やはり酸発生剤 が用いられる。一方、バインダー樹脂がアルカリ可溶性 であって、溶解抑止剤として塩基の作用により解裂する 基を有する化合物を用い、ポジ型に作用させる場合や、 パインダー樹脂が塩基の作用により解裂する基を有する ものであって、ポシ型に作用させる場合は、感放射線化 50 ェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、

合物として、放射線の作用により塩基を発生する塩基発 生剤が用いられる。

【0046】感放射線化合物としての酸発生剤は、その 物質自体に、又はその物質を含むレジスト組成物に、放 30 射線を照射することによって、酸を発生する各種の化合 物であることができる。例えば、オニウム塩、ハロゲン 化アルキルトリアジン系化合物、ジスルホン系化合物、 ジアゾメタンスルホニル骨格を有する化合物、スルホン 酸エステル系化合物などが挙げられる。このような酸発 生剤の具体例を以下に示す。

【0047】オニウム塩:ジフェニルヨードニウム ト リフルオロメタンスルホネート、4-メトキシフェニル フェニルヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネー ト、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウム トリ フルオロメタンスルホネート、ピス(4 - tert-ブチル フェニル) ヨードニウム テトラフルオロボレート、ビ ス(4-tert-ブチルフェニル) ヨードニウム ヘキサ フルオロホスフェート、ビス(4 - tert-ブチルフェニ ル) ヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート、ビ ス(4-tert-ブチルフェニル) ヨードニウム トリフ ルオロメタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニ ルヨードニウム カンファースルホネート、トリフェニ ルスルホニウム ヘキサフルオロホスフェート、トリフ

トリフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホ ネート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、4-メトキシフェニ ルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホ ネート、p-トリルジフェニルスルホニウム トリフル オロメタンスルホネート、2,4,6-トリメチルフェ ニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスル ホネート、4-tert-ブチルフェニルジフェニルスルホ ニウム トリフルオロメタンスルホネート、4-フェニ ルチオフェニルジフェニルスルホニウム ヘキサフルオ 10 ロホスフェート、4-フェニルチオフェニルジフェニル スルホニウム ヘキサフルオロアンチモネート、1-(2-ナフトイルメチル) チオラニウム ヘキサフル オロアンチモネート、1-(2-ナフトイルメチル)チ オラニウム トリフルオロメタンスルホネート、4ーヒ ドロキシー1-ナフチルジメチルスルホニウム ヘキサ フルオロアンチモネート、4-ヒドロキシー1-ナフチ ルジメチルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネ ートなど。

17

【0048】ハロゲン化アルキルトリアジン系化合物: 2-メチル-4, 6-ビス(トリクロロメチル)-1, 3,5-トリアジン、2,4,6-トリス(トリクロロ メチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-フェニルー 4, 6-ビス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリア ジン、2-(4-クロロフェニル)-4,6-ビス(ト リクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(4 ーメトキシフェニル) -4,6-ビス(トリクロロメチ ル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(4-メトキシー 1-ナフチル)-4,6-ピス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(ベンゾ[d][1. 3] ジオキソラン-5-イル)-4,6-ビス(トリク ロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン、2-(4-メ トキシスチリル) -4, 6-ビス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(3, 4, 5-トリメト キシスチリル)-4,6-ビス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(3, 4-ジメトキシス チリル) -4, 6-ピス(トリクロロメチル) <math>-1, 3, 5-トリアジン、2-(2, 4-ジメトキシスチリ −トリアジン、2−(2−メトキシスチリル)−4,6 ーピス(トリクロロメチル)-1, 3, 5-トリアジン、 2-(4-ブトキシスチリル)-4,6-ビス(トリク ロロメチル)-1、3、5-トリアジン、2-(4-ペ ンチルオキシスチリル)-4.6-ピス(トリクロロメ チル)-1,3,5-トリアジンなど。

【0049】ジスルホン系化合物:ジフェニル ジスルホン、ジーpートリル ジスルホン、フェニル pートリル ジスルホン、フェニル pーメトキシフェニルジスルホンなど。

【0050】ジアゾメタンスルホニル骨格を有する化合 50

物: ビス (フェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (4-クロロフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-トリルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (4-te rt-ブチルフェニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (2.4-キシリルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、(ベンゾ イル) (フェニルスルホニル) ジアゾメタンなど。 【0051】スルホン酸エステル系化合物:1-ベンゾ イル-1-フェニルメチル p-トルエンスルホネート (通称ベンゾイントシレート)、2-ベンゾイル-2-ヒドロキシ-2-フェニルエチル p-トルエンスルホ ネート(通称α-メチロールベンゾイントシレート)、 1、2、3-ベンゼントリイル トリスメタンスルホネ ート、2, 6-ジニトロベンジル p-トルエンスルホ ネート、2-ニトロベンジル p-トルエンスルホネー ト、4-ニトロベンジル p-トルエンスルホネート、 N- (フェニルスルホニルオキシ) スクシンイミド、N – (トリフルオロメチルスルホニルオキシ)スクシンイ ミド、N-(ブチルスルホニルオキシ)スクシンイミ ド、N- (10-カンファースルホニルオキシ) スクシ ンイミド、N- (トリフルオロメチルスルホニルオキ シ) フタルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニ ルオキシ) -5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシ イミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ) ナフタルイミド、N-(10-カンファースルホニルオ キシ) ナフタルイミドなど。

【0052】感放射線化合物としての塩基発生剤も、その物質自体に、又はその物質を含むレジスト組成物に、放射線を照射することによって、塩基を発生する各種の30 化合物であることができる。その具体例としては、2-ニトロベンジル シクロヘキシルカーバメート、2,6-ジニトロベンジル シクロヘキシルカーバメート、ホルムアニリド、水酸化トリフェニルスルホニウムなどが挙げられる。これらの化合物は、放射線の作用により分解して、アミンやヒドロキシルアニオンを生成する。

【0053】また、一般に酸発生剤を用いる化学増幅型のレジスト組成物においては、塩基性化合物、特に塩基性含窒素有機化合物、例えばアミン類を、クェンチャーとして添加することにより、放射線照射後の引き置きに40 伴う酸の失活による性能劣化を改良できることが知られており、本発明においても、感放射線化合物として酸発生剤を用いる場合は、このような塩基性化合物を配合するのが好ましい。クェンチャーに用いられる塩基性化合物の具体的な例としては、以下の各式で示されるようなものが挙げられる。

[0054]

【0056】式中、R11及びR11は互いに独立に、水 素、水酸基で置換されていてもよいアルキル、シクロア ルキル又はアリールを表し、R¹¹、R¹⁴及びR¹¹は互い に独立に、水素、水酸基で置換されていてもよいアルキ ル、シクロアルキル、アリール又はアルコキシを表し、 R16は水酸基で置換されていてもよいアルキル又はシク ロアルキルを表し、Aはアルキル、アルキレン、カルボ ニル、イミノ、ジスルフィド、スルフィド又は2級アミ ンを表す。R¹¹~R¹⁶で表されるアルキル及びR¹³~R 11で表されるアルコキシは、それぞれ炭素数1~6程度 であることができ、R¹¹~R¹⁶で表されるシクロアルキ ルは、炭素数5~10程度であることができ、そしてR 11~R11で表されるアリールは、炭素数6~10程度で あることができる。また、Aで表されるアルキレンは、 炭素数1~6程度であることができ、直鎖でも分岐して いてもよい。

【0057】さらには、特開平11-52575号公報に開示されているような、ピペリジン骨格を有するヒンダードアミン化合物をクエンチャーとすることもできる。

【0058】本発明のレジスト組成物は、その全固形分量を基準に、バインダー成分を60~99.9重量%程度、そして感放射線化合物を0.1~20重量%程度の範囲で含有するのが好ましい。ポジ型レジストであって、溶解抑止剤を用いる場合は、上記バインダー成分の内数として、レジスト組成物の全固形分量を基準に、5~40重量%程度の範囲で含有するのが適当である。ネガ型

レジストの場合には、同じくレジスト組成物の全固形分量を基準に、架橋剤を1~30重量%程度の範囲で含有するのが適当である。バインダー樹脂が、放射線照射後の感放射線化合物の作用によりアルカリ可溶性となるものであって、ボジ型に作用し、レジスト組成物の大部分がバインダー樹脂と感放射線化合物で占められる場合、バインダー樹脂の量は、組成物中の全固形分量を基準に80重量%程度以上となるようにするのが適当である。また、感放射線化合物が酸発生剤であって、クェンチャーとして塩基性化合物を用いる場合は、同じくレジスト組成物の全固形分重量を基準に、0.01~1重量%程度の範囲で含有するのが好ましい。この組成物はまた、必要に応じて、増感剤、他の樹脂、界面活性剤、安定剤、染料など、各種の添加物を少量含有することもできる。

40 【0059】本発明のレジスト組成物は通常、上記の各成分が溶剤に溶解された状態でレジスト液となり、シリコンウェハーなどの基体上に、スピンコーティングなどの常法に従って塗布される。とこで用いる溶剤は、各成分を溶解し、適当な乾燥速度を有し、溶剤が蒸発した後に均一で平滑な塗膜を与えるものであればよく、この分野で一般に用いられている溶剤が使用しうる。例えば、エチルセロソルブアセテート、メチルセロソルブアセテート及びプロビレングリコールモノメチルエーテルアセテートのようなグリコールエーテルエステル類、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類、

. 乳酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル及びピルビン酸エ チルのようなエステル類、アセトン、メチルイソプチル ケトン、2-ヘプタノン及びシクロヘキサノンのような ケトン類、アーブチロラクトンのような環状エステル類 などを挙げることができる。これらの溶剤は、それぞれ 単独で、又は2種以上組み合わせて用いることができ る。

【0060】基体上に塗布され、乾燥されたレジスト膜 には、バターニングのための露光処理が施され、次いで 脱保護基反応又は架橋反応を促進するための加熱処理を 行った後、アルカリ現像液で現像される。ことで用いる アルカリ現像液は、との分野で用いられる各種のアルカ リ性水溶液であることができるが、一般には、テトラメ チルアンモニウムヒドロキシドや (2-ヒドロキシエチ ル) トリメチルアンモニウムヒドロキシド(通称コリ ン)の水溶液が用いられることが多い。

[0061]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら 限定されるものではない。例中にある部は、特記ないか 20 ぎり重量基準である。また重量平均分子量は、ポリスチ レンを標準品として、ゲルパーミェーションクロマトグ ラフィーにより求めた値である。

【0062】モノマー合成例1(メタクリル酸2-メチ ルー2-アダマンチルの合成)2-メチルー2-アダマ ンタノール83.1gとトリエチルアミン101gを仕 込み、200gのメチルイソブチルケトンを加えて溶液 とした。そこに、メタクリル酸クロリド78.4g(2 - メチル - 2 - アダマンタノールに対して 1 .5 モル 倍)を滴下し、その後、室温で約10時間攪拌した。濾 過後、有機層を5重量%重炭酸ナトリウム水溶液で洗浄 し、続いて水洗を2回行った。有機層を濃縮した後、減 圧蒸留して、次式で示されるメタクリル酸2-メチルー 2-アダマンチルを得た。

[0063]

【0064】モノマー合成例2(αーメタクリロイロキ シーィーブチロラクトンの合成) αープロモーィーブチ ロラクトン100gとメタクリル酸104.4g(α-ブロモーャーブチロラクトンに対して2.0モル倍)を 仕込み、αーブロモーγーブチロラクトンの3重量倍の メチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。そこにト リエチルアミン183.6g (αープロモーャープチロ ラクトンに対して3.0モル倍)を滴下し、その後、室 温で約10時間攪拌した。濾過後、有機層を5重量%重 炭酸ナトリウム水溶液で洗浄し、続いて水洗を2回行っ 50 0℃まで昇温し、4-メチル-2-ペンタノン 7gに

た。有機層を濃縮して、次式で示されるα-メタクリロ

[0065]

【0066】樹脂合成例 (A1)

イロキシーャーブチロラクトンを得た。

磁気攪拌子、冷却管、温度計、窒累導入管を備えた10 0mL三つ口フラスコに、2-トリフルオロメチルアク リル酸 [関東化学(株)より入手] 5.81g、2-(2-メチルアダマンタン) メタクリル酸 エステル 9. 72g、メチルイソブチルケトン10.5gを加 え、窒素置換を行った後に80℃に昇温し、アゾビスイ ソブチロニトリル〇、34gをメチルイソブチルケトン 10gに溶解した溶液を30分かけて滴下した。その後 80℃に保ったまま8時間保温した。この反応液を30 °Cまで冷却した後にトリエチルアミン7.5gを1時間 かけて滴下した。その後35~45℃でα−ブロモ−ァ -ブチロラクトン8.56gを2時間かけて滴下した。 45℃に保ったまま8時間反応を行った。その後濾過 し、濾液を6回水洗した。水洗後の有機層を濃縮後2-ヘブタノンを加え濃縮し、65%メタノール水に滴下 し、析出した樹脂を濾過、乾燥し樹脂A1を得た。得量 14.05g.

[0067] 樹脂合成例(A2)

磁気攪拌子、冷却管、温度計、窒素導入管を備えた10 0mL三つ口フラスコに、t-ブチル 5-ノルボルネ ン-2-カルボキシレート15.54g、無水マレイン 酸7.84g、メタクリル酸 ヘキサフルオロイソプロ ピル9.44g、メチルイソブチルケトン22gを仕込 んだ。窒素置換を行った後に80℃に昇温し、アゾビス イソブチロニトリル0.82gをメチルイソブチルケト ン11gに溶解した溶液を30分かけて滴下した。その 後80℃に保ったまま8時間保温した。その後メタノー ル250g、水100gの混合溶液に反応液を注ぎ、析 出した樹脂をプロピレングリコールメチルエーテルアセ テートに溶解し、濃縮することにより樹脂溶液を得た。 得量64.55g。固形分21.40%。これを樹脂A 2とする。

[0068]樹脂合成例(A3)

冷却管、温度計、磁気攪拌子、滴下ロートを備えた10 0m1三つ口フラスコに、2-メチルアダマンチル ビ シクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2-カルボキ シレート(NB-2MAd)8.59g、無水マレイン酸 (MA) 2. 94g、3-(パーフルオロ-3-メチル ブチル) -2-ヒドロキシプロピル アクリレート (T FMC700HAA) 5. 97g、4-メチル-2-ペ ンタノン10gをしとみ、窒素置換を行った。その後8

溶解したAIBNO. 31gを30分かけて滴下した。 その後80℃で8時間保温した。冷却後メタノール30 0m1に反応液を滴下し析出した樹脂を濾過により得 た。40℃で減圧乾燥を8時間行い樹脂10.2gを得 た。ポリスチレン換算重量平均分子量 (Mw) 640 * * 0。 これを樹脂A3とする。

【0069】樹脂合成例(A4、A5、X1) 樹脂A3の合成例と同様の操作により下表の樹脂を得

24

[0070]

Μw 仕込みモノマー組成 NB-TB/MA/TFMC70HAA = 40/40/206100 樹脂合成例A4 5500 NB-2Mad/MA/TFMC70HAA = 45/45/10樹脂合成例A5 樹脂合成例X1 $NB_{TB}/MA = 50/50$ 5400

NB-TB: 2-メチルプロピル ピシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2

- カルボキシレート

【0071】樹脂合成例(A6)

冷却管、温度計、磁気攪拌子、滴下ロートを備えた10 0m1三つ口フラスコに、2-アダマンチルプロビル ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2-カルボ キシレート (NB-AdTB) 9. 43g、MA 2. 94g、TFMC70HAA 5. 97g、4-メチル -2-ベンタノン 10gをしこみ、窒素置換を行っ た。その後80℃まで昇温し、4-メチルー2ーペンタ ノン 7gに溶解したAIBNO. 31gを30分かけ て満下した。その後80℃で8時間保温した。冷却後へ キサン300mlに反応液を滴下し析出した樹脂を濾過 により得た。40℃で減圧乾燥を8時間行い樹脂7.3 gを得た。ポリスチレン換算重量平均分子量(Mw)1 0900。これを樹脂A6とする。

【0072】樹脂合成例(A7)

仕込みモノマーのモル比をNB-AdTB/MA/TFMC70HMA=40 /40/20とする以外は、樹脂合成例A6と同様の操 作を行い樹脂を得た。ポリスチレン換算重量平均分子量 (Mw) 16700。 これを樹脂A7とする。

【0073】樹脂合成例(A8)

冷却管、温度計、磁気撹拌子、滴下ロートを備えた10 0m1三つ口フラスコに、2-アダマンチル メタクリ レート (2MAdMA) 7.03g、TFMC7OH MA 12.37g、4-メチル-2-ペンタノン 10%

※gをしてみ、窒素置換を行った。その後80℃まで昇温 し、4-メチル-2-ペンタノン 7gに溶解したAI BNO. 25gを30分かけて滴下した。その後80℃ で8時間保温した。冷却後ヘキサン300m1に反応液 を滴下し析出した樹脂を濾過により得た。40℃で減圧 乾燥を8時間行い樹脂10.5gを得た。ポリスチレン 換算重量平均分子量 (Mw) 24000。 これを樹脂A 8とする。

【0074】樹脂合成例(X2)

メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチルとα-メタ クリロイロキシーャーブチロラクトンを5:5のモル比 (15.0g:11.7g)で仕込み、全モノマーの2重 量倍のメチルイソブチルケトンを加えて溶液とした。そ こに、開始剤としてアゾビスイソプチロニトリルを全モ ノマー量に対して2モル%添加し、80℃で約8時間加 熱した。その後、反応液を大量のヘブタンに注いで沈殿 させる操作を3回行い、精製した。その結果、重量平均 分子量が10000の共重合体を得た。これを樹脂X2 30 とする。

【0075】実施例1~8及び比較例1、2 以下の各成分を混合し、さらに孔径0.2μmのフッ素 樹脂製フィルターで濾過して、レジスト液を調製した。 [0076]

樹脂

10 部

酸発生剤:p_トリルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート 0.2 部 〔みどり化学(株)より入手した"MDS-205"〕

クュンチャー : 2, 6 - ジイソプロピルアニリン 0.015 部 : プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 100 部 溶剤

【0077】ヘキサメチルジシラザンを用いて23℃で 20秒間処理したシリコンウェハーに、上で調製したレ ジスト液を乾燥後の膜厚が 0.1 μmとなるよう塗布し た。プリベークは、120℃、60秒の条件で、ダイレ クトホットプレート上にて行った。こうしてレジスト膜 を形成したウェハーに、簡易型F、エキシマレーザー路 光機 (リソテックジャパン (株) から入手した "VUVES-4500"〕を用い、露光量を段階的に変化させてオーブン フレーム露光した。露光後は、ダイレクトホットプレー ト上にて、120℃で60秒間のポストエキスポジャー 50 レクトホットプレート上にてプリベークして、レジスト

ベーク (PEB) を行い、さらに2.38重量%テトラ メチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のパ ドル現像を行った。現像後のウェハーを目視観察して、 レジストが膜抜けする最少露光量(膜抜け感度)を求 め、表1の結果を得た。

【0078】一方、フッ化マグネシウムウェハーに、先 に調製したレジスト液及び樹脂のみをプロピレングリコールモノメ fルエーテルアセテート溶媒に溶解した液を乾燥後の膜厚が 0.1 μ mとなるよう塗布し、120°C、60秒の条件で、ダイ

゙ 膜を形成させた。こうして形成されたレジスト膜の波長 157nmにおける透過率を、上で用いた簡易型F。エキ シマレーザー露光機の透過率測定機能を用いて測定し、*

*表1に示す結果を得た。 [0079] 【表1】

	樹脂 膜抜け感度		透過率 樹脂のみ	レジスト	
———— 実施例 1	A 1	2 mJ/cm²	35 %	35%	
実施例2	A 2	5 mJ/cm²	36 %	33%	
実施例3	А3	3 mJ/cm²	32 %	30%	
実施例4	A 4	4.5 mJ/cm²	38 %	36%	
実施例5	A 5	4 mJ/cm²	28 %	26%	
実施例6	A 6	2.5 mJ/cm²	33 %	31%	
実施例7	A 7	3.5 mJ/cm²	30 %	29%	
実施例8	A 8	1 mJ/cm²	44 %	43%	
比較例1	X 1	8 mJ/cm²	26 %	25%	
比較例2	X 2	3 mJ/cm²	25 %	25%	

【0080】樹脂合成例(A9)

磁気攪拌子、冷却管、温度計、窒素導入管を備えた10 20 0mLフラスコに、メタクリル酸 3-(パーフルオロー 3-メチルブチル)-2-ヒドロキシプロビル〔ダイキ ン化成品販売(株)より入手〕10.31g、p-t-ブ トキシスチレン17.63g、メチルイソブチルケトン 31gを仕込んだ。窒素置換を行った後に80℃に昇温 し、アゾピスイソブチロニトリル〇、82gをメチルイ ソブチルケトン11gに溶解した溶液を30分かけて滴 下した。その後80℃に保ったまま8時間保温した。そ の後メタノール250g、水100gの混合溶液に反応 解し、濃縮することにより57.6gの樹脂溶液を得 た。この樹脂溶液にメチルイソブチルケトン62.8 g、p-トルエンスルホン酸3.0g、水9.7gを加 えて70℃で15時間保温した。との反応液を5回水洗 を行い濃縮後、プロピレングリコールメチルエーテルア セテート300gを加え更に濃縮し、樹脂溶液を得た。 得量65.3g。固形分27.21%。重量平均分子量 14900。この樹脂を樹脂A9とする。

【0081】樹脂合成例(A10)

磁気攪拌子、冷却管、温度計、窒素導入管を備えた20 0mLフラスコに、メチルイソプチルケトン26.81 gを仕込んだ。窒素置換を行った後に84℃に昇温し、※

※別途、メタクリル酸 3-(パーフルオロ-3-メチルブ

チル)-2-ヒドロキシプロピル〔ダイキン化成品販売 (株)より入手〕9.89g、p-t-ブトキシスチレン 16.92g、アゾビスイソブチロニトリル1.97g をメチルイソブチルケトン26.81gに溶解した溶液 を1時間かけて滴下した。その後84℃に保ったまま8 時間保温した。その後メタノール247.23g、水1 23.61gの混合溶液に反応液を30分かけて滴下 し、得られた樹脂をメチルイソプチルケトンに溶解し、 濃縮することにより67.03gの樹脂溶液を得た。こ の樹脂溶液にメチルイソブチルケトン93.52g、p 液を注ぎ、析出した樹脂をメチルイソプチルケトンに溶 30 -トルエンスルホン酸3.49g、水11.26gを加 えて70℃で15時間保温した。この反応液を5回水洗 を行い濃縮後、n-ヘプタン446.88g中に30分 かけて滴下し、得られた樹脂をろ過、減圧乾燥を行い、 樹脂を得た。得量17.07g。重量平均分子量440 0。これを樹脂A10とする。

> 【0082】樹脂X3:日本曹達(株)製のポリ(p-ピニルフェノール) (商品名 "VP-2500") の水酸基を 平均保護率20%でイソプロビル基で保護した樹脂。

【0083】実施例9、10及び比較例3

40 以下の各成分を混合し、さらに孔径0.2 µmのフッ素樹 脂製フィルターで濾過して、レジスト液を調製した。 [0084]

樹脂(固形分として)

架橋剤: ヘキサメトキシメチルメラミン

10 部

0.5部

酸発生剤: N- (イソプロピルスルホニルオキシ) スクシンイミド

1.1 部 0.0125 部

クェンチャー : 1,3-シ (4-ピリジル)プロパン

溶剤(樹脂持ち込み分を加えて):プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

100 部

【0085】Brewer 社製の有機反射防止膜用組成物で ある"DUV-42を塗布し、215℃、60秒の条件でベー

コンウェハーに、上で調製したレジスト液を乾燥後の膜 厚が 0.523μ mとなるようにスピンコートした。レジ クして、厚さ 600人の有機反射防止膜を形成させたシリ 50 スト液塗布後は、100℃、60秒の条件でダイレクト ホットプレート上にてプリベークした。こうしてレジス ト膜を形成したウェハーに、KrFエキシマステッパー 〔(株)ニコン製の"NSR 2205EX-12B"、NA=0.55、 σ =0. 8) を用い、露光量を段階的に変化させてラインアンド スペースパターンを露光した。露光後は、ホットプレー ト上にて105℃、60秒の条件でポストエキスポジャ ーベーク(PEB)を行い、さらに2.38 重量%テトラ メチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のパ ドル現像を行った。現像後のラインアンドスペースパタ 度及び解像度を調べた。

【0086】実効感度: 0.20 µmのラインアンドス ペースパターンが1:1となる露光量で表示した。

【0087】解像度: 実効感度の露光量で分離するラ米

* インアンドスペースパターンの最小寸法で表示した。 【0088】一方、フッ化マグネシウムウェハーに、先 に調製したレジスト液及び樹脂のみをプロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート溶媒に溶解した液を乾燥後の膜厚が 0.1 μ mとなるよう塗布し、100℃、60秒の条件で、ダイ レクトホットプレート上にてプリベークして、レジスト 膜を形成させた。とうして形成されたレジスト膜の波長 157nmにおける透過率を、簡易型F、エキシマレーザ -露光機(リソテックジャパン製 VUVES-450 ーンを走査型電子顕微鏡で観察し、以下の方法で実効感 10 0)の透過率測定機能を用いて測定し、表2に示す結果 を得た。

28

[0089] 【表2】

樹脂		透過率		実効感度(KrF)	解像度(KrF)	
		樹脂のみ	レジスト			
 実施例9	A 9	40 %	40%	18 mJ/cm²	0.16μm	
実施例10	A 1 0	39%	38 %	90 mJ/cm²	0.15µm	
比較例3	Х3	27%	27 %	27 mJ/cm²	0.16μm	

【0090】樹脂合成例(A11)

磁気攪拌子、窒素導入管、ジムロート冷却管、温度計及 び滴下ロートを備えた四つ口フラスコに、メタクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル9.37g、メタクリル 酸1-トリフルオロメチル-2、2、2-トリフルオロ エチル [東京化成工業(株)より入手] 9.44g、ア ゾピスイソブチロニトリル0.263g及びメチルイソ ブチルケトン40.9gを仕込み、雰囲気を窒素に置換 した。その後、系内に窒素を流しながらオイルバスを用 いて80℃まで昇温し、約7時間保温した。冷却後、反※ ※応液を1 dm のメタノール中に攪拌しながら滴下した。 30分間攪拌した後、濾過して、白色粉末25.8gを 得た。との白色粉末を、減圧下に60℃で約6時間乾燥 して、8.4gの樹脂を得た。収率45%。重量平均分 子量10200。とれを樹脂A11とする。

【0091】実施例11及び比較例4

30 以下の各成分を混合し、さらに孔径0.2 µmのフッ素樹 脂製フィルターで濾過して、レジスト液を調製した。 [0092]

樹脂(固形分換算)

10 部

酸発生剤:p-トリルジフュニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホネート 0.2 部

〔みどり化学(株)より入手した"MDS-205"〕

0.015 部 クェンチャー : ジシクロヘキシルメチルアミン

: 実施例 2_ヘプタノン 溶剤

100部

比較例 プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート/γープチロラクトン(95/5) 100部

【0093】Brewer 社製の有機反射防止膜用組成物で ある "DUV-30]-14" を塗布し、2 1 5 ℃、6 0 秒の条件 でベークして、厚さ 1,600人の有機反射防止膜を形成さ せたシリコンウェハーに、上で調製したレジスト液を乾 爆後の膜厚が0.39 μmとなるようにスピンコートし た。レジスト液塗布後は、ダイレクトホットプレート上 にて120℃、60秒の条件でプリベークした。こうし てレジスト膜を形成したウェハーに、ArFエキシマス テッパー [(株)ニコン製の "NSR ArF"、NA=0.55、σ= 0.6) を用い、露光量を段階的に変化させてラインアン ドスペースパターンを露光した。露光後は、ホットプレ 50

40 ート上にて120℃、60秒の条件で60秒間ポストエ キスポジャーベーク (PEB) を行い、さらに2.38重 置%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で6 〇秒間のパドル現像を行った。現像後のラインアンドス ペースパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、以下の方 法で実効感度及び解像度を調べた。結果を表3に示す。 【0094】実効感度: 0.18 μmのラインアンドス ペースパターンが1:1となる露光量で表示した。 【0095】解像度: 実効感度の露光量で分離するラ インアンドスペースパターンの最小寸法で表示した。

【0096】一方、フッ化マグネシウムウェハーに、先

゙に調製したレジスト液及び樹脂のみをプロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート溶媒に溶解した液を乾燥後の膜厚が 0.1 μ mとなるよう塗布し、120°C、60秒の条件で、ダイ レクトホットプレート上にてプリベークして、レジスト 膜を形成させた。こうして形成されたレジスト膜の波長 157nmにおける透過率を、簡易型F。エキシマレーザ× * - 露光機〔リソテックジャパン(株)から入手した"VU VES-4500" 〕の透過率測定機能を用いて測定し、表3に 示す結果を得た。

[0097] 【表3】

	樹脂	透過 樹脂のみ	•	実効感度	解像度
実施例11	A 11	30 %	30%	42 mJ/cm²	0.16μm
上較例4	X 2	25 %	2 5%	36mJ/cm²	0.16μm

【0098】樹脂合成例(A12)

攪拌棒、冷却管、温度計、窒素導入管を備えた100m Lフラスコに、 p-アセトキシスチレン9.73g、 アクリル酸 t - ブチル2. 56g、メタクリル酸3-(パーフルオロー3-メチルプチル)-2-ヒドロキシブ ロピル〔ダイキン化成品販売(株)より入手〕7.96g 20 とイソプロパノール13.51gを仕込んで窒素置換を し、80℃まで昇温した。別途、アゾビスイソプチロニ トリル0. 41gをイソプロパノール6. 75gに溶解 した溶液を0.5時間かけて滴下した。80℃で6時間 保温した後、メタノールと水の混合液中に滴下し晶析さ せ、濾過、乾燥し、15.69gの樹脂を得た。得られ た樹脂15.69gと4-ジメチルアミノピリジン1. 57gとメタノール47.07gを攪拌棒、冷却管、温 度計、窒素導入管を備えた100mLフラスコに仕込ん で、還流下、15時間熟成した。冷却後、氷酢酸0.9 3gで中和し、水784.50g中にチャージし、晶析 させ、濾過により結晶を取り出した。その後、結晶をア セトンに溶かし、水にチャージし晶析させ、濾過により 結晶を取り出し、この操作を計3回繰り返した後、得ら れた結晶を乾燥し、12.59gの樹脂を得た。重量平 均分子量は37000、分散度3.72(GPC法:ポ リスチレン換算) であった。これを樹脂A12とす

【0099】樹脂合成例(A13)

攪拌棒、冷却管、温度計、窒素導入管を備えた100m 40 Lフラスコに、 p-アセトキシスチレン9. 73g、 メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル4.69g 、メタクリル酸 3-(パーフルオロ-3-メチルブチ ル)-2-ヒドロキシブロピル〔ダイキン化成品販売 (株)より入手〕7.96gとイソプロパノール13.9 2gを仕込んで窒素置換をし、80℃まで昇温した。別 途、アゾビスイソブチロニトリル0. 41gをイソプロ パノール7.46gに溶解した溶液を0.5時間かけて 滴下した。80℃で6時間保温した後、メタノールと水 の混合液中に滴下し晶析させ、濾過し、22.08gの 50 チレン共重合体(30:70)53.2g(モノマー単

樹脂を得た。得られた樹脂22.08gと4-ジメチル アミノピリジン2.21gとメタノール110gを撹拌 棒、冷却管、温度計、窒素導入管を備えた300mLフ ラスコに仕込んで、還流下、15時間熟成した。冷却 後、氷酢酸2.21gで中和し、水2000g中にチャ ージし、晶析させ、濾過により結晶を取り出した。その 後、結晶をアセトンに溶かし、水にチャージし晶析さ せ、濾過により結晶を取り出し、との操作を計3回繰り 返した後、得られた結晶を乾燥し、11.51gの樹脂 を得た。重量平均分子量は30900、分散度1.99 (GPC法:ポリスチレン換算) であった。これを樹 脂A13とする。

【0100】樹脂合成例(X4)

重量平均分子量が12600、分散度1.87 (GPC 法:ポリスチレン換算)のt-ブチルアクリレートとス 30 チレンとpーヒドロキシスチレン共重合体(丸善石化 (株) 製のTSM-4)の共重合比は、核磁気共鳴(**) C-NMR) 分光計により、約20:20:60と求め られた。

【0101】樹脂合成例(X5)

(1)フラスコに、 メタクリル酸2-アダマンチル-2 -メチル24.6g(O.105モル)とp -アセトキ シスチレン39.7g(0.245モル)とイソプロパ ノール128.6gを仕込んで窒素置換をし、75℃ま で昇温した。その溶液に、ジメチル2、2-アゾビス (2-メチルプロピオネート) 4.84g(0.021 モル)をイソプロパノール9.7gに溶かしてから滴下 した。75℃で約0.5時間、還流下で約11時間熱成 した後、アセトンで希釈し、ヘプタンにチャージし、晶 析させ、濾過により結晶を取り出し、得られた結晶を乾 燥した。得られたメタクリル酸2-アダマンチル-2-メチルと p - アセトキシスチレン共重合体の結晶は5 4. 1gであった。

【0102】(2)フラスコに、上記で得られたメタクリ ル酸2-アダマンチル-2-メチルとp-アセトキシス

位として0.29モル)と4-ジメチルアミノビリジン 5. 3g(0.043 モル)とメタノール159.5 gを仕込んで、還流下、20時間熟成した。冷却後、氷 酢酸3.92g(0.065モル)で中和し、水にチャ ージし、晶析させ、濾過により結晶を取り出した。その 後、結晶をアセトンに溶かし、水にチャージし、晶析さ せ、濾過により結晶を取り出し、この一連の操作を計3 回繰り返した後、得られた結晶を乾燥した。得られたメ タクリル酸2-アダマンチル-2-メチルとp-ヒドロ キシスチレン共重合体の結晶は41.2gであった。ま 10 た、重量平均分子量は8100、分散度1.68 (GP) C法:ポリスチレン換算)であり、共重合比は核磁気共 鳴 (13C-NMR) 分光計により、約30:70と求め られた。この樹脂を樹脂X5とする。

【0103】樹脂合成例(X6)

(1)フラスコに、 メタクリル酸2-アダマンチル-2 ~メチル16.4g(0.07モル)とp-アセトキシ スチレン45.4g(0.28モル)とイソプロパノー ル123.6gを仕込んで窒素置換をし、75℃まで昇 温した。その溶液に、ジメチル2 '2-アゾビス(2- 20 メチルプロピオネート) 4.84g(0.021モル) をイソプロパノール9、7gに溶かしてから滴下した。 75℃で約0.5時間、還流下で約11時間熱成した 後、アセトンで希釈し、ヘプタンにチャージし、晶析さ せ、濾過により結晶を取り出し、得られた結晶を乾燥し*

*た。得られたメタクリル酸2-アダマンチル-2-メチ ルとp-アセトキシスチレン共重合体の結晶は54.2 gであった。

【0104】(2)フラスコに、上記で得られたメタクリ ル酸2-アダマンチル-2-メチルとp-アセトキシス チレン共重合体(20:80)53.0g(モノマー単 位として0.30モル)と4-ジメチルアミノピリジン 5. 3g(0.043 モル) とメタノール159.0 gを仕込んで、還流下、20時間熟成した。冷却後、氷 酢酸3.13g(0.052モル)で中和し、水にチャ ージし、晶析させ、濾過により結晶を取り出した。その 後、結晶をアセトンに溶かし、水にチャージし、晶析さ せ、濾過により結晶を取り出し、この一連の操作を計3 回繰り返した後、得られた結晶を乾燥した。得られたメ タクリル酸2-アダマンチル-2-メチルとp-ヒドロ キシスチレン共重合体の結晶は37.8gであった。ま た、重量平均分子量は約7900、分散度1.72(G PC法:ポリスチレン換算)であり、共重合比は核磁気 共鳴(13C-NMR)分光計により、約20:80と求 められた。 この樹脂を樹脂X6とする。

【0105】実施例12及び比較例5 以下の各成分を混合し、さらに孔径0.2 µmのフッ素樹 脂製フィルターで濾過して、レジスト液を調製した。 [0106]

10 部

10部

酸発生剤:ビス(4-t-プチルフュニルヨードニウム カンファースルホネート 0.52 部

0.052 部 クェンチャー : トリイソフ゜ロハ゜ノールアミン 100 部 溶剤 :乳酸エチル

【0107】実施例13及び比較例6

樹脂

樹脂

30% 脂製フィルターで濾過して、レジスト液を調製した。

以下の各成分を混合し、さらに孔径0.2 µmのフッ素樹※

[0108]

酸発生剤:ピス(4-t-ブ チルフュニルヨードニウム カンファースルホネート 0.52 部

0.052 部 クェンチャー : 2,6-シ イソブ ロヒ ルアニリン

溶剤 :メチルアミルケトン 100 部

【0109】ヘキサメチルジシラザンを用いて23℃で 20秒間処理したシリコンウェハーに、上で調製したレ ジスト液を乾燥後の膜厚が 0.1 μmとなるよう塗布し た。ブリベークは、130℃、60秒の条件で、ダイレ クトホットプレート上にて行った。こうしてレジスト膜 40 を形成したウェハーに、簡易型F,エキシマレーザー露 光機〔リソテックジャパン(株)から入手した "VUVES-4500"〕を用い、露光量を段階的に変化させてオープン フレーム露光した。露光後は、ダイレクトホットプレー ト上にて、140℃で60秒間のポストエキスポジャー ベーク(PEB)を行い、さらに2.38重量%テトラ メチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のパ ドル現像を行った。現像後のウェハーを目視観察して、★

★レジストが膜抜けする最少露光量(膜抜け感度)を求 め、表4の結果を得た。

【0110】一方、フッ化マグネシウムウェハーに、先 に調製したレジスト液及び樹脂のみをプロピレングリコールモノメ fルエーテルブセテート溶媒に溶解した液を乾燥後の膜厚が 0.1 μ mとなるよう塗布し、130°C、60秒の条件で、ダイ レクトホットプレート上にてプリベークして、レジスト 膜を形成させた。とうして形成されたレジスト膜の波長 157mにおける透過率を、真空紫外分光器(日本分光 製 VUV-200) 用いて測定し、表4に示す結果を 得た。

[0111]【表4】

特開2002-6501

33			樹脂のみ	レジスト
実施例12	A 1 2	2.5 mJ/cm²	30%	31%
実施例13	A 1 3	0.5mJ/cm²	27%	27%
———— 比較例5	X 4	2mJ/cm²	24%	25%
比較例6	X5/X6=1	3mJ/cm²	21%	22%

[0112] ーザーを用いた露光において、高い透過率を示し、Kr* できる。

*F、ArF 露光での解像度も高く、充分なコントラスト 【発明の効果】本発明のレジスト組成物は、170 nm以 10 を有するので、170 nm以下の波長の光源を用いる化学 下の波長の光源、例えば波長157nmのF、エキシマレ 増幅型のレジストとして、優れた性能を発揮することが

フロントペー	・ジの続き	•				
(51)Int.Cl.	7	識別記号		FΙ		テーマコード(参考)
C08K	5/00			C 0 8 K	5/00	
CO8L	33/06			C08L	33/06	
	33/16				33/16	
	35/00				35/00	
	45/00				45/00	
G03F	7/004	503		G03F	7/004	503A
						503B
	7/038	601			7/038	6 0 1
H01L	21/027	,		H01L	21/30	5 0 2 R
(32)優先日	主張国 宮 芳士 大阪市山 友化学二 井上 「 大阪市」	比花区春日出中3丁目1番98号 C業株式会社内	住	F ターム (省	43002	BE07 BE10 BF02 BF08 BF09 BF11 BG00 CB43 CC20 FA17 BG041 BG051 BG081 BH021 BK001 EU186 EV166 EV216 EV246 EV256 EW046 EV016 EY026 FD206 GP03 AB07S AK31R AK32R AL08P AL08Q AL24P AL26P AR11R BA03P BA03R BA03S BA04S BA11P BA11R BA16R BA20R BB01P BB03P BB12P BB18P BC04R BC07P BC09P BC09Q
						BCO9R BC53P BC55R CA04
		•				CA05 JA38

33